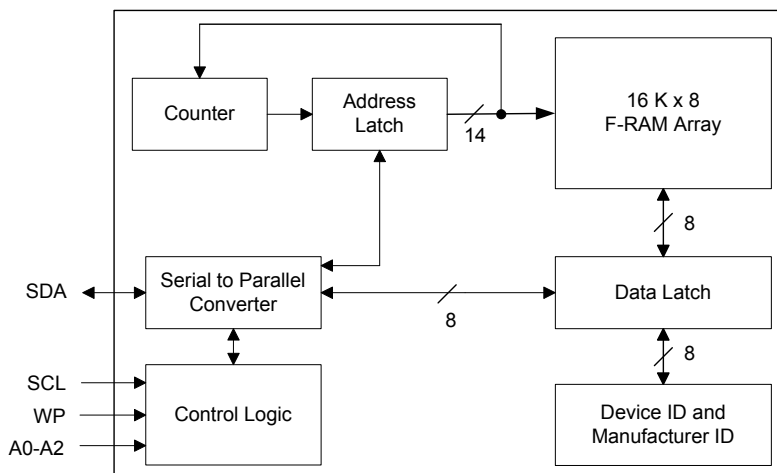


## 特性

- 128 Kbit 铁电随机存储器 (F-RAM) 被逻辑组织为 16 K × 8
  - 高耐久性: 100 万亿 (10<sup>14</sup>) 次的读 / 写操作
  - 151 年的数据保留时间 (请参考数据保留时间与耐久性表)
  - NoDelay™ 写操作
  - 可靠性较高的高级铁电工艺
- 快速的双线串行接口 (I<sup>2</sup>C)
  - 最大频率为 3.4 MHz
  - 可以直接替代串行 EEPROM 的硬件
  - 支持在 100 kHz 和 400 kHz 频率时的旧版计时器
- 器件 ID
  - 制造商 ID 和产品 ID
- 低功耗
  - 当频率为 100 kHz 时, 活动电流为 175 mA
  - 待机电流为 150 mA
  - 睡眠模式电流为 8 mA
- 工作电压较低: V<sub>DD</sub> = 2.0 V 到 3.6 V
- 工业温度范围: -40 °C 到 +85 °C
- 8 引脚小外型集成电路 (SOIC) 封装
- 符合有害性物质限制 (RoHS)

## 逻辑框图



## 功能概述

FM24V01A 是一个采用高级铁电工艺的 128 Kbit 非易失性存储器。F-RAM 是非易失性的; 与 RAM 相同, 它能够执行读和写操作。它提供 151 年的可靠数据保留时间, 同时解决了由 EEPROM 和其他非易失性存储器所造成的复杂性、开销和系统级可靠性等问题。

与 EEPROM 不同, FM24V01A 以总线速度执行写操作。并不会产生写延迟。在每个字节成功传输到设备后, 数据立即被写入到存储器阵列。这时, 可以开始执行下一个总线周期而不需要数据轮询。此外, 与其他非易失性存储器相比, 该产品提供了更多的擦写次数。在写操作期间, F-RAM 的功耗也远远低于 EEPROM, 因为写电路不需要高电源电压。FM24V01A 能够支持 10<sup>14</sup> 读 / 写周期, 或支持比 EEPROM 多 1 亿次的写周期。

由于具有这些特性, 因此 FM24V01A 适用于需要频繁或快速写入的非易失性存储器应用。应用的范围包括从数据采集 (其中写周期数量是非常重要的) 到满足工业控制 (其中 EEPROM 的较长写时间会使数据丢失)。通过各特性的组合, 系统可以更频繁地进行数据写入而只需要较少的开销。

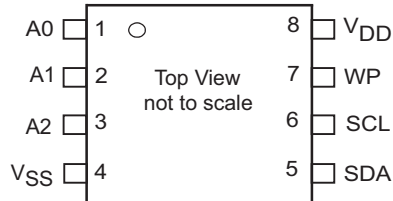
FM24V01A 使用硬件直接替代串行 (I<sup>2</sup>C) EEPROM 时, 可为用户带来极大的方便。该器件包含一个只读的器件 ID, 通过该 ID, 主机可以确定制造商、产品容量和产品版本。在 -40 °C 到 +85 °C 的工业温度范围内, 该器件规范受保证。

## 目录

引脚分配 .....	3	最大额定值 .....	11
引脚定义 .....	3	工作范围 .....	11
概述 .....	4	直流电气特性 .....	11
存储器架构 .....	4	数据保留时间与耐久性 .....	12
双线接口 .....	4	电容 .....	12
STOP事件 (P) .....	4	热电阻 .....	12
START事件 (S) .....	4	交流测试负载和波形 .....	12
数据/地址传输 .....	5	交流测试条件 .....	12
确认/否认 .....	5	交流开关特性 .....	13
高速模式 (Hs模式) .....	6	电源循环时序 .....	14
从设备地址 .....	6	订购信息 .....	15
寻址概述 .....	6	订购代码定义 .....	15
数据传输 .....	6	封装图 .....	16
存储器操作 .....	6	缩略语 .....	17
写操作 .....	6	文档规范 .....	17
读操作 .....	7	测量单位 .....	17
睡眠模式 .....	9	文档修订记录页 .....	18
器件ID .....	10	销售、解决方案和法律信息 .....	19

## 引脚分配

图 1. 8 引脚 SOIC 的引脚分配



## 引脚定义

引脚名称	I/O 类型	说明
A0-A2	输入	<b>器件选择地址 0-2</b> 。使用这些引脚可选择同一个双线总线上最多 8 个相同类型器件中的一个。要选择器件，三个引脚的地址必须与从设备地址内的对应位相匹配。内部下拉地址引脚。
SDA	输入 / 输出	<b>串行数据地址</b> 。这是双线接口的双向引脚。它是开漏引脚，用以与双线总线上其他器件执行“与”运算。输入缓冲区包含一个用以实现抗噪能力的施密特触发器；输出驱动器包括下降沿的斜率控制。需要使用一个外部上拉电阻。
SCL	输入	<b>串行时钟</b> 。是指双线接口的串行时钟引脚。器件的数据从下降沿上输出，并从上升沿上输入。SCL 输入也可包含一个用来实现抗噪能力的施密特触发器输入。
WP	输入	<b>写保护</b> 。当与 V <sub>DD</sub> 连接时，整个存储器映射中的地址均受写保护。当 WP 接地时，可对所有地址进行写操作。内部下拉该引脚。
V <sub>SS</sub>	电源	器件的接地引脚。必须连接至系统地面端。
V <sub>DD</sub>	电源	器件的电源输入。

## 概述

FM24V01A 是一个串行的 F-RAM 存储器。该存储器阵列被逻辑组织为 16,384 × 8 位，并可通过行业标准的二线（I<sup>2</sup>C）接口访问。F-RAM 和串行 EEPROM 的功能操作是相同的。FM24V01A 与具有相同引脚分配的串行 EEPROM 的主要区别在于 F-RAM 具有更好的写性能、高耐久性以及低功耗。

## 存储器架构

当访问 FM24V01A 时，用户寻址 16 K 地址的每 8 个数据位。这些 8 数据位被连续移入或移出。通过使用具有一个从设备地址（以与其他非存储器设备区分开来）和一个 2 字节地址的 I<sup>2</sup>C 协议，可以访问这些地址。该地址范围的高 2 位都是‘无需关注’的值。14 位的完整地址独立指定每个字节的地址。

存储器的访问时间几乎为零，但要考虑串行协议所需要的时间。因此，该存储器以 I<sup>2</sup>C 总线速度进行读 / 写操作。与串行 EEPROM 不同，不必轮询器件的就绪条件，因为写操作是以总

线速度进行的。新的总线数据操作移入器件前，需要完成写操作。第 6 页上的存储器操作中详细介绍了该功能。

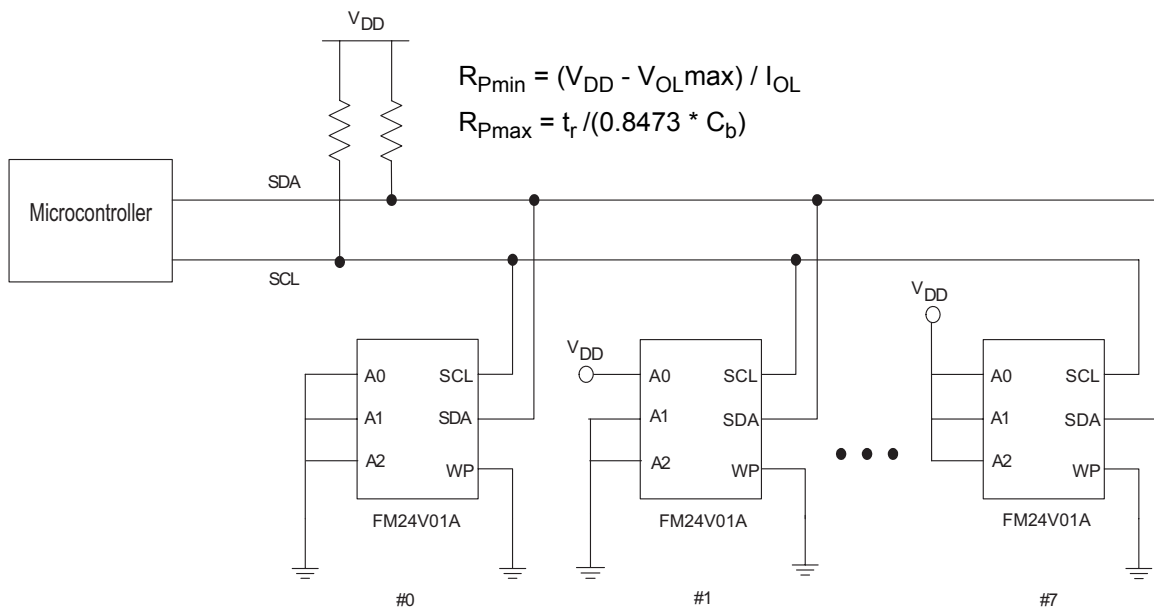
## 双线接口

FM24V01A 采用了使用几个引脚或较少电路板空间的双向 I<sup>2</sup>C 总线协议。图 2 显示的是在基于微控制器系统上使用 FM24V01A 的典型系统配置。许多用户已对行业标准的 I<sup>2</sup>C 总线很熟悉，但在本章节仍然对此进行了说明。

按约定，将数据发送到总线的任意设备称为发送器，而接收数据的目标设备称为接收器。控制总线的器件就是主设备。主设备负责给所有操作生成时钟信号。在总线上被控制的任何器件又称从设备。FM24V01A 总是从设备。

总线协议由 SDA 和 SCL 信号上的切换状态控制。共有四种条件，其中包括：启动（START）、停止（STOP）、数据位和确认。图 3 和第 5 页上的图 4 说明了指定四种状态的信号条件。“电气规范”一节中已对时序图进行了详细介绍。

图 2. 使用串行（I<sup>2</sup>C）F-RAM 的系统配置



## STOP 事件（P）

总线主设备将 SDA 从低电平切换至高电平（同时 SCL 信号为高电平）时，表示 STOP 事件。使用 FM24V01A 的所有操作要以 STOP 事件结束。当激活 STOP 事件时，正在运行的某个操作将被终止。主设备需要控制 SDA（并非存储器读取操作），以激活 STOP 事件。

## START 事件（S）

总线主设备将 SDA 从高电平切换至低电平（同时 SCL 信号为高电平）时，表示发生 START 事件。发送所有指令之前，需要生成一个 START 事件。随时激活 START 事件，便可终止正在运行的操作。使用 START 事件终止某个操作会使 FM24V01A 准备执行新操作。

在操作过程中，如果电源下降到比指定的 V<sub>DD</sub> 更小的值，则在执行其他操作前，系统需要发出 START 事件。

图 3. START 和 STOP 事件

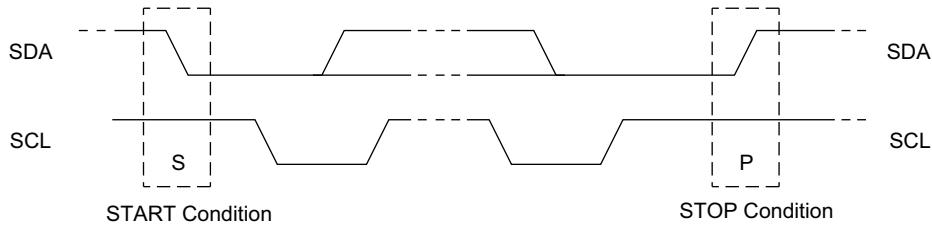
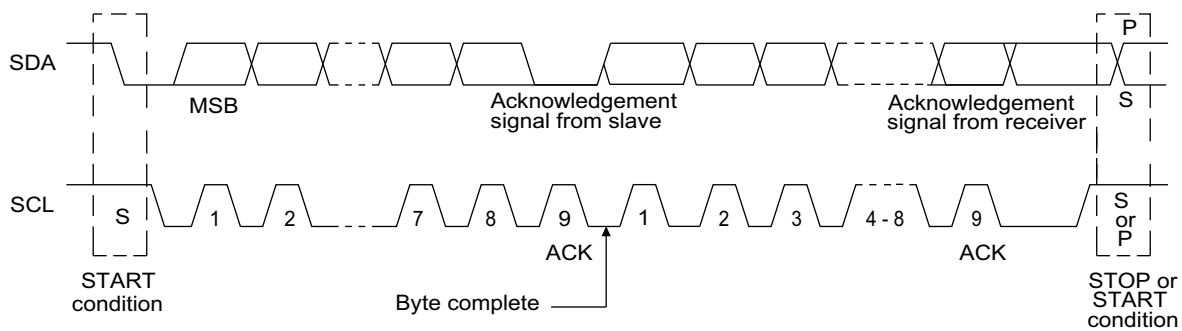


图 4. I<sup>2</sup>C 总线上的数据传输



**数据 / 地址传输**

当 SCL 信号为高电平时，会进行所有数据的传输（包括地址）。除了在上述 3 种事件下，SCL 为高电平时也不能更改 SDA 信号。

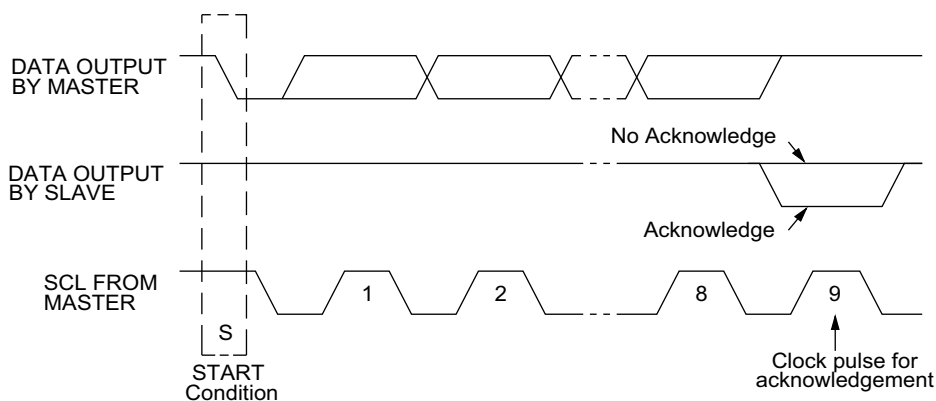
**确认 / 否认**

在任何数据传输中，第 8 个数据位被传输之后，会发生确认事件。在该状态中，发送器应该释放 SDA 总线，以允许接收器驱动该信号。接收器将 SDA 信号置于低电平，以确认收到字节。如果接收器不将 SDA 信号置于低电平，则会发生否认事件，并终止操作。

接收器确认失败的原因有两个，第一个是字节传输失败。在这种情况下，否认事件终止当前操作，以便再次对器件进行寻址。这样允许最后字节在通信错误事件发生时恢复。

第二个也是最常见的原因是接收器不确认故意终止操作。比如，在读取操作过程中，只要接收器发出确认（和时钟信号）数据包，FM24V01A 会持续将数据放置在总线上。当读操作已完成，且不需要发送任何数据时，接收器不必确认最后的字节。如果接收器确认了最后一个字节，在主设备正在发出新指令（如停止事件）时，FM24V01A 会尝试在下一个时钟周期内驱动总线。

图 5. 在 I<sup>2</sup>C 总线上确认

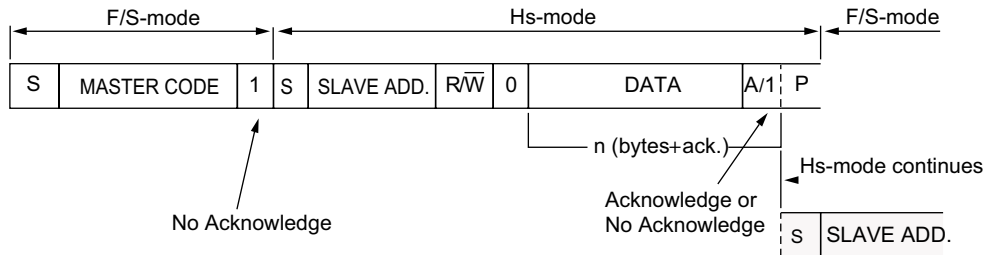


### 高速模式 (Hs 模式)

FM24V01A 支持 3.4 MHz 的高速模式。必须生成主设备代码 (00001XXXb)，以将器件置于高速模式。主设备和从设备间的

通信将被启用，以达到最高速率 3.4 MHz。STOP 事件将退出高速模式。支持单字节和多字节读写。

图 6. 高速模式下的数据传输格式

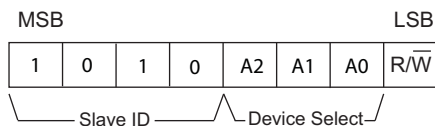


### 从设备地址

发出 START 事件后，FM24V01A 所期望接收的第一个字节是从设备地址。如图 7 中所示，从设备地址包括器件类型或从设备 ID、器件选择地址位以及一个指定读 / 写操作的位。

对于 FM24V01A，位 7-4 是设备类型（从设备 ID）以及应该被设置为 1010b。这些位允许同一个地址范围的双线总线具有不同的功能类型。位 3-1 是器件选择地址位。它们要符合于外部地址引脚的对应值，以选择器件。通过对每个器件分配不同的地址，多达 8 个 FM24V01A 器件可以常驻于同一个双线总线上。位 0 是读 / 写位 (R/W)。R/W = '1' 表示读操作，R/W = '0' 表示写操作。

图 7. 存储器从器件地址



### 寻址概述

FM24V01A（如接收器）确认从设备地址后，主设备可以将存储器地址放置在总线上，以实现写操作。该地址需要使用两个字节。14 位的完整地址被内部锁存。每个访问操作均使所锁存的地址值自动递增。当前地址是保留在锁存器中的值，无论它是新写入的值还是最后的访问操作后的地址。只要保持电源或在写入新的值前，仍会保留当前地址。读操作一直使用当前地址。通过执行如下解释的写操作，可以加载某个随机读取地址。

传输每个数据字节后，执行确认条件前，FM24V01A 会增加内部地址锁存器。这样可以访问下一个连续字节而无需额外地址。达到最后地址 (3FFFh) 后，地址锁存将翻转到 0000h。单个读或写操作访问的字节数量不受限制。

### 数据传输

地址字节被发送后，可以开始进行总线主设备与 FM24V01A 之间的数据传输。对于读操作，FM24V01A 将 8 个数据位置于总线上，然后等待主设备发出确认信号。如果主设备发出了确认信号，FM24V01A 将传输下一个连续字节。如果不发生确认事件，FM24V01A 将终止读操作。对于写操作，FM24V01A 将接收来自主设备的 8 个数据位，然后发出确认信号。所有数据传输操作都优先发送 MSB（最高有效位）。

### 存储器操作

FM24V01A 的操作方式被设计为与其他双线接口存储器产品的操作方式相同。主要差异是由于 F-RAM 技术的更高性能和写入功能引起的。这些改进使得 FM24V01A 与具有相同配置的 EEPROM 之间在写操作中存在一些差异。下面内容对读和写的完整操作进行了加以说明。

### 写操作

所有写操作都从从设备地址开始，然后轮到存储器地址。通过设置从设备地址的 LSB (R/W 位) 为 '0'，总线主设备将指示一个写操作。寻址之后，总线主设备将每一个数据字节发送到存储器内，然后存储器生成一个确认事件。可以写入任意连续字节数量。如果达到地址范围的终点，地址计数器将从 3FFFh 返回 0000h。

与其他非易失性存储器技术不同，使用 F-RAM 技术时没有有效的写操作延迟。因为基础存储器的读写访问时间相等，所以用户体验到总线上没有延迟。整个存储器周期的发生时间短于单个总线时钟周期。因此，完成某个写入操作后，可以立即发生任何读或写操作。不需要使用数据应答轮询技术 (EEPROM 使用该技术来确定写操作是否完成)，并且会始终返回就绪条件。

在内部中，传输第 8 个数据位后，会发生实际存储器写操作。发出确认条件前，会完成该操作。因此，如果用户需要中止写操作而不修改存储器内容，应该通过发生第 8 个数据位前使用 START 事件或 STOP 事件来实现该操作。FM24V01A 不使用页缓冲区。

通过使用 WP 引脚，可以对存储器阵列进行写保护。将 WP 引脚设置为高电平状态 (V<sub>DD</sub>)，便可对所有地址进行写保护。FM24V01A 将不确认被写入到保护地址的数据字节。此外，如果尝试写入这些地址，地址计数器将不增加。将 WP 引脚设置为低电平状态 (V<sub>SS</sub>)，便可禁用写保护。WP 被内部下拉。

图8和图9显示的是全速模式下的单字节和多字节写周期。图10则显示高速模式下的单字节写周期

图 8. 单字节写入

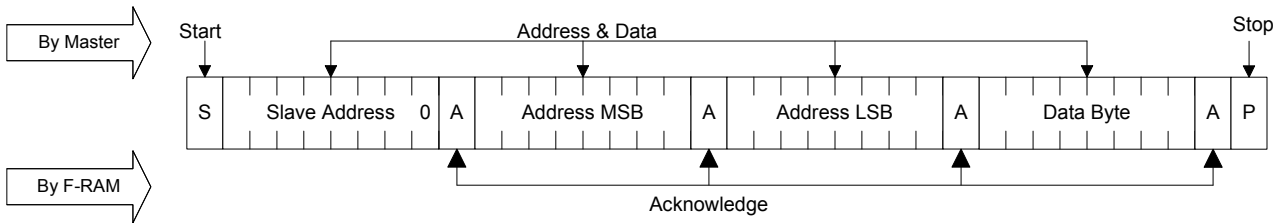


图 9. 多字节写入

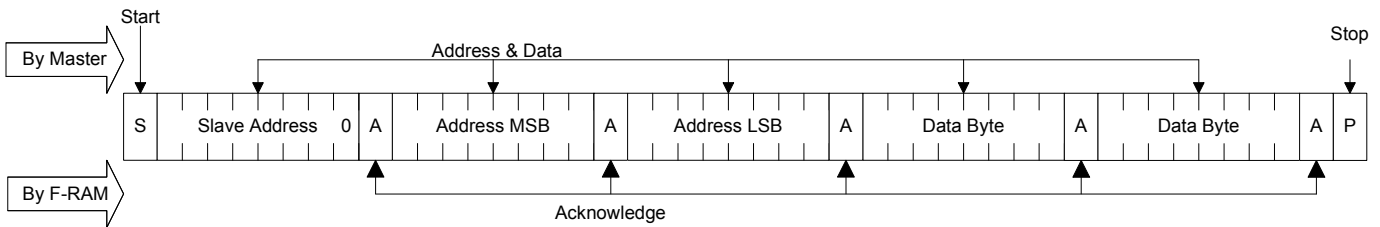
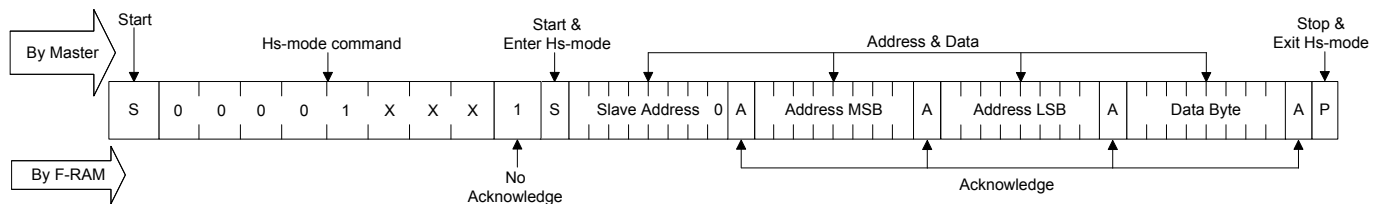


图 10. 高速模式下的字节写入



**读操作**

读操作具有两种基本类型。它们分别为当前地址读取和选择性地址读取。对于当前地址读取，FM24V01A 使用内部地址锁存器来提供地址。对于选择性地址读取，用户将地址设置为指定值。

*当前地址读取和连续读取*

如上面所述，FM24V01A 通过使用内部锁存器给读操作提供地址。进行读操作时，当前地址读取会将地址锁存器中现有的值作为起始地址使用。系统从最后操作地址的随后地址开始读取。

为执行当前地址读取，总线主设备提供具有 LSB 被设为 ‘1’ 的从设备地址。这指示请求了一个读操作。接收完整从设备地址后，FM24V01A 在下一个时钟上将当前地址开始移出数据。当前地址是内部地址锁存器中所保留的值。

从当前地址开始，总线主设备可以读取任意字节数。因此，一个连续读取仅是一个进行多字节传输的当前地址读取。传输每个字节后，内部地址计数器会增加。

**注意:** 每次总线主设备确认某个字节时，会指示 FM24V01A 可以读取下一个连续字节。

可以通过四种方式进行适当地终止读操作。不适当终止读操作将导致总线冲突，比如 FM24V01A 尝试读取总线上的额外数据。四种有效方法具体为：

1. 总线主设备在第 9 个时钟周期内发送一个否认条件，并在第 10 个时钟周期内发送 STOP 事件。下面框图描述了该操作。这是首选方法。
2. 总线主设备在第 9 个时钟周期发送否认条件，并在第 10 个时钟周期内发送 START 事件。
3. 总线主设备在第 9 个时钟周期发送 STOP 事件。
4. 总线主设备在第 9 个时钟周期发送 START 事件。

如果内部地址达到 3FFFh，它将在下一个读周期中返回 0000h。  
 图 11 和图 12 显示的是当前地址读取的正确操作。

图 11. 当前地址读取

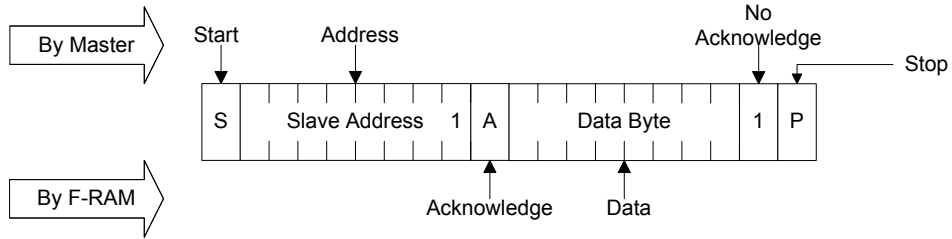


图 12. 连续读取

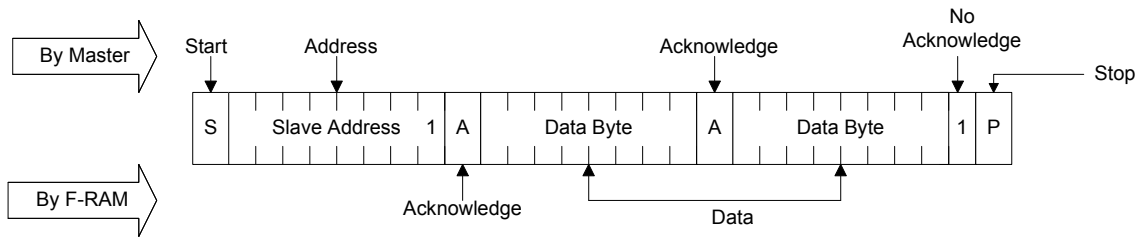
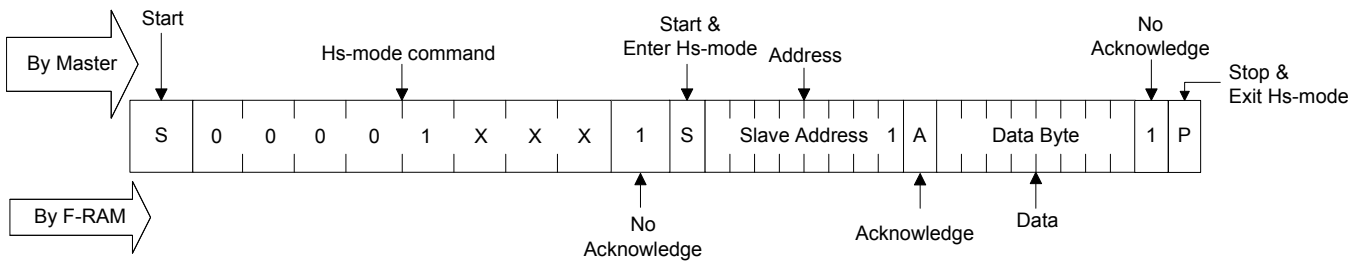


图 13. 高速模式下的当前地址读取



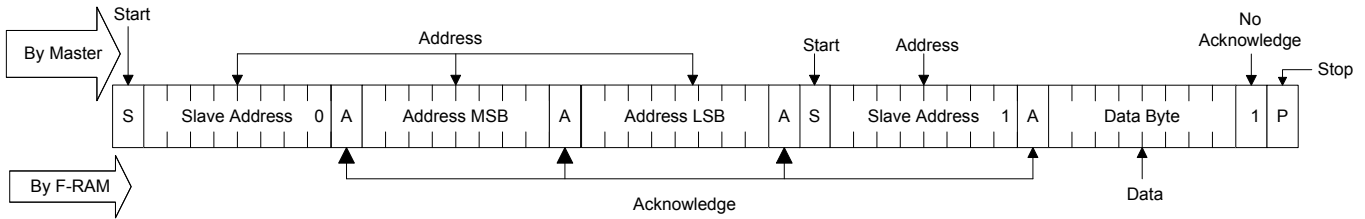


**选择性（随机）读取**

通过一种简单的技术，用户可以选择一个随机地址位置作为读操作的起始地址。该技术使用写操作的前三个字节来设置后续读操作随后的内部地址。

为执行一个选择性读取，总线主设备发出具有 LSB (R/W) 被设置为 0 的从设备地址。这样表示一个写操作。根据写协议，总线主设备会发送被加载到内部地址锁存器中的地址字节。FM24V01A 确认地址后，总线主设备将发出 START 事件。这样会中止写操作，同时允许通过将设备地址的 LSB 设置为 '1' 来发出读指令。该操作现在是当前地址读取。

图 14. 选择性（随机）读取



**睡眠模式**

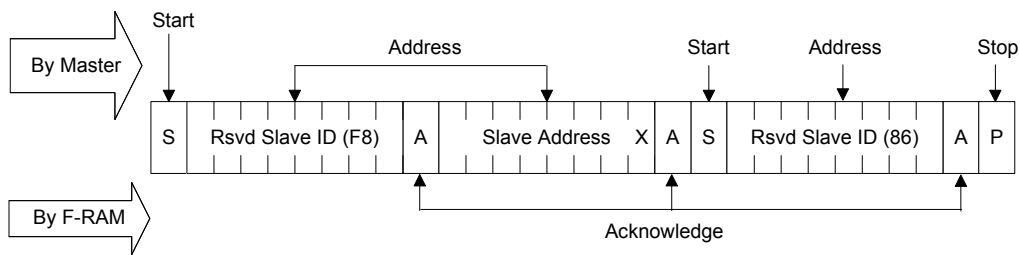
低功耗模式又称为睡眠模式可以在 FM24V01A 器件上实现。当睡眠指令 86h 被输入时，器件会进入低功耗模式。按照以下操作可以进入睡眠模式：

1. 主设备发送 START 指令。
2. 主设备发送保留的从设备 ID 0xF8。
3. FM24V01A 发送 ACK。
4. 主设备将所需识别的从设备的从设备地址发送到 I<sup>2</sup>C 总线。最后一位是“无需关注”的值 (R/W 位)。一个器件必须确认该字节（该字节包含 I<sup>2</sup>C 总线从设备地址）。
5. FM24V01A 发送 ACK。

6. 主设备发送 Re-START（重新启动）指令。
7. 主设备发送保留的从设备 ID 0x86。
8. FM24V01A 发送 ACK。
9. 主设备发送 STOP，以确保器件进入睡眠模式。

一旦进入睡眠模式，器件消耗 I<sub>ZZ</sub> 电流，但是器件继续监控 I<sup>2</sup>C 引脚。一旦主设备发送了 FM24V01A 所确认的从设备地址，器件将“唤醒”，并在 t<sub>REC</sub>（最长为 400 ms）时间内准备好执行正常的操作。主设备可以发送读或写指令，并寻找 ACK，这是确定器件何时就绪的另一种方法。正在唤醒器件时，它会 NACK 主设备，直到它就绪为止。

图 15. 进入睡眠模式



## 器件 ID

FM24V01A 器件提供数据的三个字节（即制造商 ID、产品 ID 和芯片版本）来识别器件。器件 ID 是只读的。可以按照下面步骤访问器件 ID:

1. 主设备发送 START 指令。
2. 主设备发送保留的从设备 ID 0xF8。
3. FM24V01A 发送 ACK。
4. 主设备将所需识别的从设备的从设备地址发送到 I<sup>2</sup>C 总线。最后一位是“无需关注”的值（R/W 位）。一个器件必须确认该字节（该字节包含 I<sup>2</sup>C 总线从设备地址）。
5. FM24V01A 发送 ACK。
6. 主设备发送 Re-START（重新启动）指令。
7. 主设备发送保留的从设备 ID 0xF9。
8. FM24V01A 发送 ACK。
9. 可以执行器件 ID 读取，首先是 12 个制造商位，其次是 9 个器件标识位和最后是 3 个芯片版本位。
10. 主设备通过 NACK 最后字节可以结束器件 ID 读序列，从而复位从设备状态机，并允许主设备发送 STOP 指令。

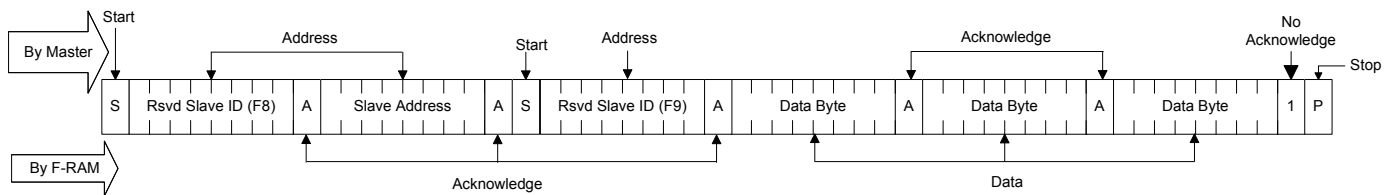
**注意：**发送 NACK 指令可以随时停止器件 ID 的读取。

表 1. 器件 ID

器件 ID (3 个字节)	器件 ID 描述			
	23–12 (12 位)	11–8 (4 位)	7–3 (5 位)	2–0 (3 位)
	制造商 ID	产品 ID		
容量		变量	芯片版本	
004101h	00000000100	0001	00000	001

**注意：**产品 ID 位 0 和位 4 均被保留。

图 16. 读取器件 ID



## 最大额定值

超过最大额定值可能会缩短器件的使用寿命。这些用户指导未经过测试。

存放温度 ..... -55 °C 至 +125 °C  
 最高结温 ..... 95 °C  
 与  $V_{SS}$  相对的  $V_{DD}$  上的供电电压 ..... -1.0 V 到 +4.5 V  
 输入电压 \* ..... -1.0 V 到 +4.5 V 和  $V_{IN} < V_{DD} + 1.0 V$   
 直流电压应用在  
 高阻 (High Z) 状态下的输出 ..... -0.5 V 到  $V_{DD} + 0.5 V$   
 处于接地电位的任何引脚上的  
 瞬变电压 (< 20 ns) ..... -2.0 V 到  $V_{DD} + 2.0 V$   
 封装功率散耗能力 ( $T_A = 25 °C$ ) ..... 1.0 W

表面贴装铅焊温度 (3 秒) ..... +260 °C

静电放电电压

人体模型 (JEDEC Std JESD22-A114-B) ..... 2 kV

充电器件模型 (JEDEC 标准 JESD22-C101-A) ..... 500 V

柱锁电流 ..... > 140 mA

\* 例外: “ $V_{IN} < V_{DD} + 1.0 V$ ” 的限制并不适用于 SCL 和 SDA 输入。

## 工作范围

范围	环境温度 ( $T_A$ )	$V_{DD}$
工业级	-40°C 至 +85°C	2.0 V 至 3.6 V

## 直流电气特性

适用条件为工作范围

参数	说明	测试条件	最小值	典型值 <sup>[1]</sup>	最大值	单位	
$V_{DD}$	电源		2.0	3.3	3.6	V	
$I_{DD}$	$V_{DD}$ 平均电流	SCL 在 $V_{DD} - 0.2 V$ 与 $V_{SS}$ 之间进行切换, 其他输入的电压为 $V_{SS}$ 或 $V_{DD} - 0.2 V$ 。	$f_{SCL} = 100 \text{ kHz}$	-	-	175	$\mu A$
			$f_{SCL} = 1 \text{ MHz}$	-	-	400	$\mu A$
			$f_{SCL} = 3.4 \text{ MHz}$	-	-	1000	$\mu A$
$I_{SB}$	$V_{CC}$ 待机电流	SCL = SDA = $V_{DD}$ 。所有其他输入的电压为 $V_{SS}$ 或 $V_{DD}$ 。已发出停止 (Stop) 指令。	-	90	150	$\mu A$	
$I_{ZZ}$	睡眠模式电流	SCL = SDA = $V_{DD}$ 。所有其他输入的电压为 $V_{SS}$ 或 $V_{DD}$ 。已发出停止 (Stop) 指令。	-	5	8	$\mu A$	
$I_{LI}$	输入漏电流 (除 WP 和 A2-A0 外)	$V_{SS} \leq V_{IN} \leq V_{DD}$	-1	-	+1	$\mu A$	
	输入漏电流 (用于 WP 和 A2-A0)	$V_{SS} \leq V_{IN} \leq V_{DD}$	-1	-	+100	$\mu A$	
$I_{LO}$	输出漏电流	$V_{SS} \leq V_{OUT} \leq V_{DD}$	-1	-	+1	$\mu A$	
$V_{IH}$	输入高电平电压 (SDL, SDA)		$0.7 \times V_{DD}$	-	$V_{DD(max)} + 0.3$	V	
	输入高电平电压 (WP, A2-A0)		$0.7 \times V_{DD}$	-	$V_{DD} + 0.3$	V	
$V_{IL}$	输入低电平电压		-0.3	-	$0.3 \times V_{DD}$	V	
$V_{OL}$	输出低电平电压	$I_{OL} = 3 \text{ mA}$	-	-	0.4	V	
		$I_{OL} = 6 \text{ mA}$	-	-	0.6	V	
$R_{in}^{[2]}$	输入电阻 (WP, A2-A0)	$V_{IN} = V_{IL(Max)}$	50	-	-	k $\Omega$	
		$V_{IN} = V_{IH(Min)}$	1	-	-	M $\Omega$	
$V_{hys}$	施密特触发器输入电压迟滞	$f_{SCL} = 1 \text{ MHz}$	$0.05 \times V_{DD}$	-	-	V	
		$f_{SCL} = 3.4 \text{ MHz}$	$0.1 \times V_{DD}$	-	-	V	

### 注释:

- 典型值要求条件为: 环境温度为 25 °C,  $V_{DD} = V_{DD}$  (典型值)。并非 100% 经过了测试。
- 当输入电压低于  $V_{IL}$  时, 输入下拉电路会较强 (50 k $\Omega$ ); 输入电压高于  $V_{IH}$  时, 输入下拉电路较弱 (1 M $\Omega$ )。

### 数据保留时间与耐久性

参数	说明	测试条件	最小值	最大值	单位
T <sub>DR</sub>	数据保留时间	T <sub>A</sub> = 85°C	10	-	年
		T <sub>A</sub> = 75 °C	38	-	
		T <sub>A</sub> = 65°C	151	-	
NV <sub>C</sub>	擦写次数	在工作温度范围内	10 <sup>14</sup>	-	周期

### 电容

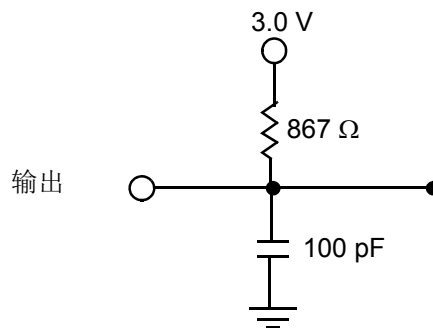
参数 <sup>[3]</sup>	说明	测试条件	最大值	单位
C <sub>IO</sub>	输入 / 输出引脚的电容 (SDA)	T <sub>A</sub> = 25 °C、f = 1 MHz、V <sub>DD</sub> = V <sub>DD</sub> (典型值)	8	pF
C <sub>I</sub>	输入引脚电容		6	pF

### 热电阻

参数 <sup>[3]</sup>	说明	测试条件	8 引脚 SOIC	单位
Θ <sub>JA</sub>	热电阻 (结温至环境温度)	根据 EIA/JESD51 的要求, 测试条件应遵循热阻的标准测试方法和过程。	146	°C/W
Θ <sub>JC</sub>	热电阻 (结温至壳温)		48	°C/W

### 交流测试负载和波形

图 17. 交流测试负载和波形



### 交流测试条件

输入脉冲电平 .....V<sub>DD</sub> 的 10% 和 90%  
 输入上升和下降时间 .....10 ns  
 输入和输出时序参考电平 .....0.5 × V<sub>DD</sub>  
 输出负载电容 ..... 100 pF

**注释:**

3. 这些参数仅通过设计保证, 并未经过测试。

## 交流开关特性

适用条件为工作范围

参数 <sup>[4]</sup>	备用参数	说明	全速模式 <sup>[6]</sup>		高速模式 <sup>[6]</sup>		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	
$f_{SCL}$ <sup>[5]</sup>		SCL 时钟频率	–	1.0	–	3.4	MHz
$t_{SU;STA}$		用于重复 Start 的 Start 事件建立时间	260	–	160	–	ns
$t_{HD;STA}$		Start 事件的保持时间	260	–	160	–	ns
$t_{LOW}$		时钟为低电平的周期	500	–	160	–	ns
$t_{HIGH}$		时钟为高电平的周期	260	–	60	–	ns
$t_{SU;DAT}$	$t_{SU;DATA}$	数据输入的建立时间	50	–	10	–	ns
$t_{HD;DAT}$	$t_{HD;DATA}$	数据输入的保留时间	0	–	0	70	ns
$t_{DH}$		从在 $V_{IL}$ 时的 SCL 到数据输出的保留时间	0	–	0	–	ns
$t_R$ <sup>[7]</sup>	$t_r$	输入上升时间	–	120	10	80	ns
$t_F$ <sup>[7]</sup>	$t_f$	输入下降时间	$20 * (V_{DD} / 5.5 V)$	120	10	80	ns
$t_{SU;STO}$		STOP 事件的建立时间	260	–	160	–	ns
$t_{AA}$	$t_{VD;DATA}$	从 SCL 为低电平到 SDA 数据输出有效的时间	–	450	–	130	ns
$t_{VD;ACK}$		ACK 输出的有效时间	–	450	–	130	ns
$t_{OF}$ <sup>[7]</sup>		从 $V_{IHmin}$ 到 $V_{ILmax}$ 的输出下降时间	$20 * (V_{DD} / 5.5 V)$	120	–	80	ns
$t_{BUF}$		新传输发生前总线处于闲置状态的时间	500	–	300	–	ns
$t_{SP}$		在 SCL、SDA 上的噪声抑制时间常量	0	50	–	5	ns

图 18. 读取总线时序图

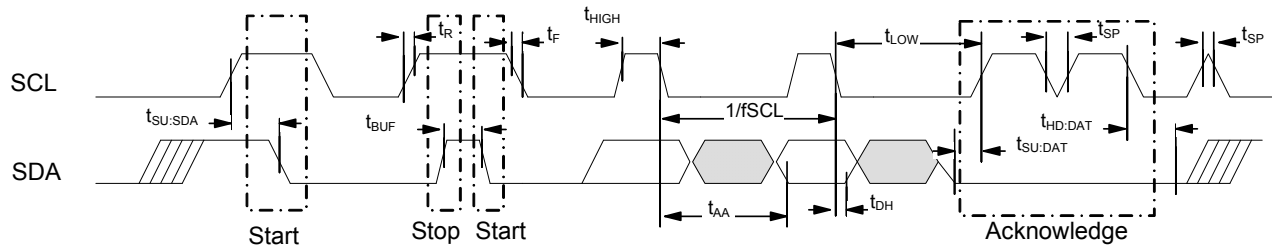
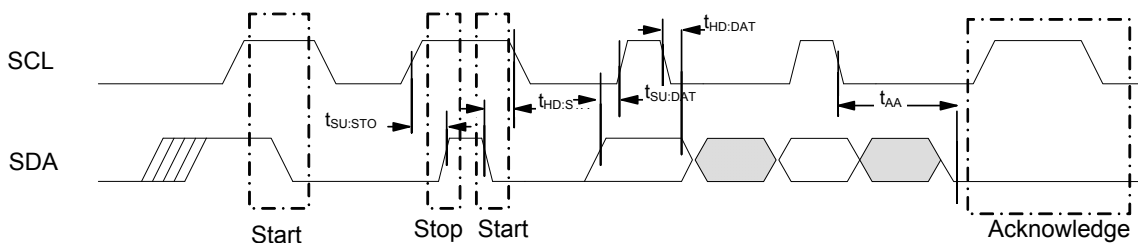


图 19. 写入总线时序图



**注释:**

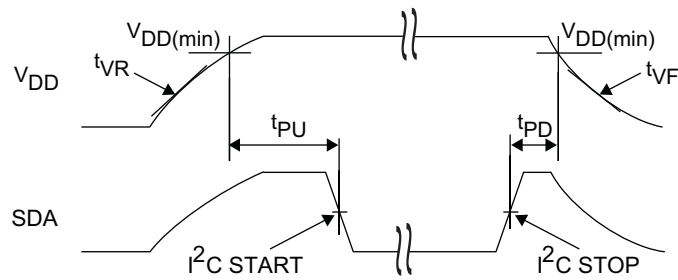
- 测试条件假设了信号跃变时间为 10 ns 或更短，时序参考电压电平为  $V_{DD}/2$ ，输入脉冲电压电平为 0 V 至  $V_{DD}$ （典型值），以及特定  $I_{OL}$  输出负载电流和 100 pF 负载电容，如图 17 所示。
- 与速度相关的规范由特性线上的各点保证，这些点位于工作频率为 DC 至  $f_{SCL}$ （最大值）的连续曲线上。
- 总线负载（Cb）的注意事项：对于 I<sup>2</sup>C 时钟频率（SCL）1 MHz，Cb < 550 pF；对于 3.4 MHz 的 SCL，Cb < 100 pF。
- 这些参数仅通过设计保证，并未经过测试。

## 电源循环时序

适用条件为工作范围

参数	说明	最小值	最大值	单位
$t_{PU}$	从加电 $V_{DD(min)}$ 到第一次访问（发生 START 事件）的时间	250	–	$\mu s$
$t_{PD}$	从最后一次访问（发生 STOP 事件）到断电（ $V_{DD(min)}$ ）的时间	0	–	$\mu s$
$t_{VR}^{[8、9]}$	$V_{DD}$ 加电升降斜率	50	–	$\mu s/V$
$t_{VF}^{[8、9]}$	$V_{DD}$ 断电升降斜率	100	–	$\mu s/V$
$t_{REC}$	从睡眠模式恢复的时间	–	400	$\mu s$

图 20. 电源循环时序



**注释:**

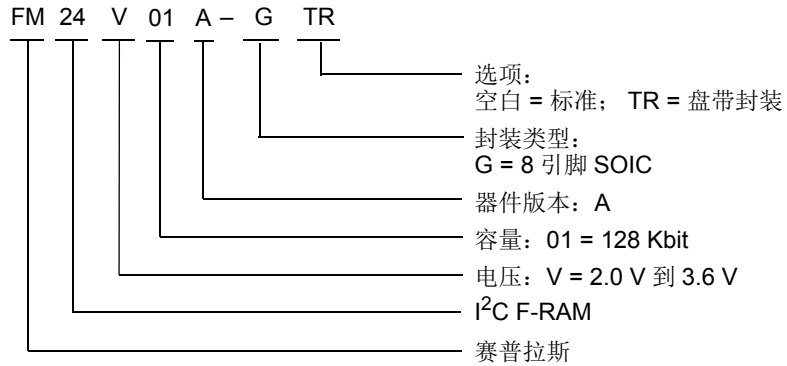
8. 在  $V_{DD}$  波形的任何位置测量斜率。
9. 这些参数仅通过设计保证，并未经过测试。

## 订购信息

订购代码	封装图	封装类型	工作范围
FM24V01A-G	51-85066	8 引脚 SOIC	工业级

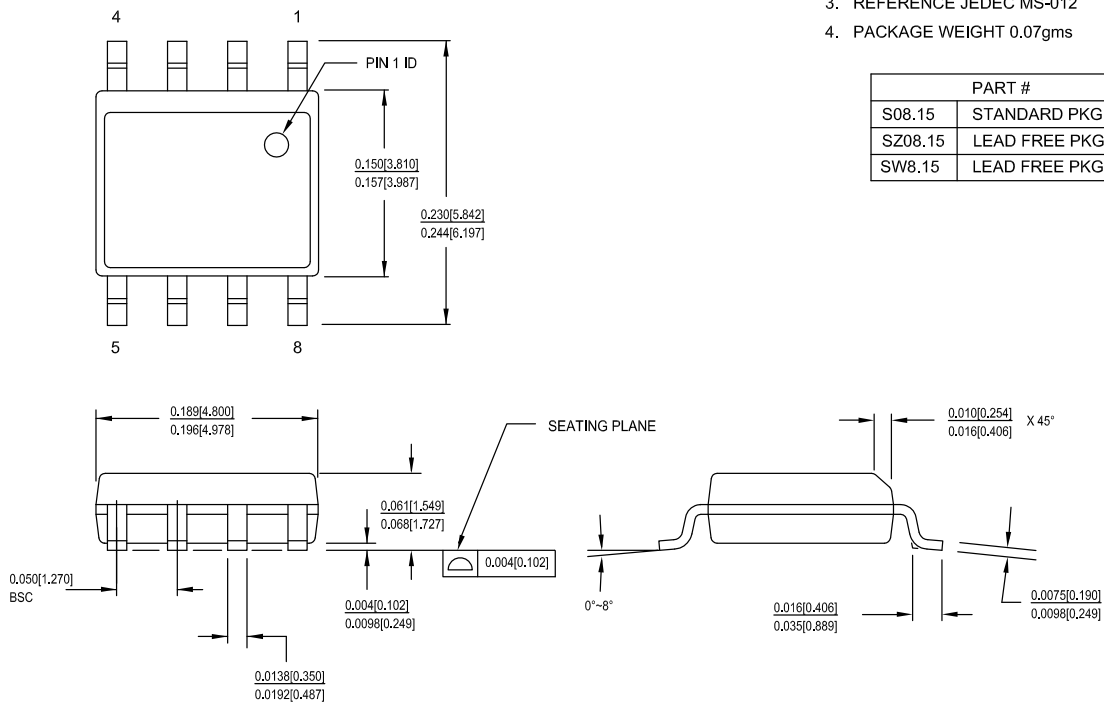
这些器件都是无铅的。要了解这些器件的供应情况，请联系赛普拉斯本地销售代表。

## 订购代码定义



封装图

图 21. 8 引脚 SOIC (150 mils) 封装外形, 51-85066



1. DIMENSIONS IN INCHES[MM] MIN. MAX.
2. PIN 1 ID IS OPTIONAL, ROUND ON SINGLE LEADFRAME RECTANGULAR ON MATRIX LEADFRAME
3. REFERENCE JEDEC MS-012
4. PACKAGE WEIGHT 0.07gms

PART #	
S08.15	STANDARD PKG
SZ08.15	LEAD FREE PKG
SW8.15	LEAD FREE PKG

51-85066 \*H



## 缩略语

缩略语	说明
ACK	确认
CMOS	互补金属氧化物半导体
EIA	电子工业联盟
I <sup>2</sup> C	内部集成电路
I/O	输入 / 输出
JEDEC	联合电子器件工程委员会
LSB	最低有效位
MSB	最高有效位
NACK	否认
RoHS	有害物质限制
R/W	读 / 写
SCL	串行时钟线
SDA	串行数据访问
SOIC	小外型集成电路
WP	写保护

## 文档规范

### 测量单位

符号	测量单位
°C	摄氏度
Hz	赫兹
KB	1024 位
kHz	千赫兹
kΩ	千欧
MHz	兆赫
MΩ	兆欧
μA	微安
μs	微秒
mA	毫安
ms	毫秒
ns	纳秒
Ω	欧姆
%	百分比
pF	皮法
V	伏特
W	瓦特

## 文档修订记录页

文档标题: FM24V01A, 128 Kbit (16 K x 8) 串行 (I <sup>2</sup> C) F-RAM				
文档编号: 001-93812				
版本	ECN 编号	原始变更	提交日期	变更说明
**	4478637	YLIU	09/08/2014	本文档版本号为 Rev**, 译自英文版 001-90869 Rev*A。
*A	5563061	GVCH	12/29/2016	更新第 14 页的 tPU, 将 1ms 更新为 250μs。